



Paper id: 252360

Printed Page: 1 of 5  
Subject Code: BEC201

Roll No:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**BTECH**  
**(SEM II) THEORY EXAMINATION 2024-25**  
**FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS ENGINEERING**

**TIME: 3 HRS****M.MARKS: 70****Note:** Attempt all Sections. In case of any missing data; choose suitably.**SECTION A****1. Attempt all questions in brief.****02 x 7 = 14**

Q no.	Question	CO	Level
a.	Compare Avalanche and Zener breakdown. एवलांच और जेनर ब्रेकडाउन की तुलना करें।	1	K2
b.	What is the physical significance of the pinch-off voltage in a JFET, and how does it affect drain current? जेएफईटी में पिन्च-ऑफ वोल्टेज का भौतिक महत्व क्या है तथा यह ड्रेन करेन्ट को कैसे प्रभावित करता है ?	1	K3
c.	Why is a differential amplifier configuration preferred as the input stage of an op-amp? डिफरेंशियल एम्प्लीफायर कॉन्फिगरेशन को ओप-एम्प के इनपुट स्टेज में क्यों प्राथमिकता दी जाती है ?	3	K2
d.	What do you mean by CMRR and Why is the Common-Mode Rejection Ratio (CMRR) critical in instrumentation applications using Op-Amps? सी.एम.आर.आर. से आपका क्या अभिप्राय है और ओप-एम्प्स का उपयोग करने वाले इंस्ट्रुमेंटेशन अनुप्रयोगों में कॉमन-मोड रिजेक्शन रेशियो (सी.एम.आर.आर.) महत्वपूर्ण क्यों है?	4	K2
e.	Why is NAND gate called a 'universal gate'? Realize NOT gate using NAND gate only. NAND गेट को 'यूनिवर्सल गेट' क्यों कहा जाता है? केवल NAND गेट का उपयोग करके NOT गेट का एहसास करें।	1	K2
f.	Find 1's and 2's complement of 10011010. 10011010 का 1's और 2's के पूरक (Complement) ज्ञात करें।	4	K4
g.	In digital wireless systems, how does frequency reuse improve spectral efficiency? डिजिटल वायरलेस प्रणालियों में फ्रीक्वेंसी री-यूज से स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है ?	1	K2



Paper id: 252360

Printed Page: 2 of 5  
Subject Code: BEC201

Roll No:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**BTECH**  
**(SEM II) THEORY EXAMINATION 2024-25**  
**FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS ENGINEERING**

**TIME: 3 HRS****M.MARKS: 70****SECTION B****2. Attempt any three of the following:****07 x 3 = 21**

Q no.	Question	CO	Level
a.	Explain the formation of a PN junction and derive the expression for the width of the depletion region. Discuss how biasing affects the junction width. पीएन जंक्शन का निर्माण प्रक्रिया समझाइए तथा डिप्लीशन क्षेत्र की चौड़ाई के लिए समीकरण व्युत्पन्न करें। बायसिंग का प्रभाव भी स्पष्ट कीजिए।	1	K2
b.	Explain the construction and working of a BJT. Draw the input and output characteristics of Common Emitter configuration. बीजेटी का निर्माण एवं कार्य प्रणाली समझाइए। कॉमन एमिटर कॉन्फिगरेशन में इनपुट एवं आउटपुट करेन्ट के बीच संबंध व्युत्पन्न कीजिए।	2	
c.	Draw and explain the Op-Amp IC-741. Also draw equivalent circuit of Op-Amp. Op-Amp IC-741 का आरेख बनाइए और समझाइए। साथ ही Op-Amp का समतुल्य परिपथ (Equivalent Circuit) भी बनाइए।	3	K3
d.	Distinguish between POS & SOP. Convert the given expression in standard SOP form. $F(A, B, C) = AB + BC + CA$ POS और SOP में अंतर स्पष्ट कीजिए। दिए गए समीकरण को मानक SOP रूप में परिवर्तित कीजिए। $F(A, B, C) = AB + BC + CA$	3	K2
e.	Draw the block diagram of a communication system and explain the function of each block. संचार प्रणाली का खण्ड आरेख बनाइए तथा प्रत्येक खण्ड का कार्य समझाइए।	4	K4

**SECTION C****3. Attempt any one part of the following:****07 x 1 = 07**

Q no.	Question	CO	Level
a.	Compare and analyze the operation and waveforms of half-wave and full-wave rectifiers. Include derivations for average and RMS current. हाफ-वेव तथा फुल-वेव रेक्टिफायर के कार्य और तरंग रूपों की तुलना एवं विश्लेषण कीजिए। औसत धारा (Average Current) तथा आरएमएस धारा (RMS Current) के लिए समीकरण की भी व्युत्पत्ति कीजिए।	4	K2



Paper id: 252360

Printed Page: 3 of 5  
Subject Code: BEC201

Roll No:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**BTECH**  
**(SEM II) THEORY EXAMINATION 2024-25**  
**FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS ENGINEERING**

**TIME: 3 HRS****M.MARKS: 70**

b.	<p>A full-wave bridge rectifier is supplied with 220V AC, 50Hz. It uses a transformer with turns ratio 10:1 and a filter capacitor of 470 <math>\mu\text{F}</math>. Calculate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peak output voltage</li> <li>Average DC output voltage</li> <li>Ripple voltage for a load of 1 k<math>\Omega</math></li> </ul> <p>एक फुल-वेव ब्रिज रेक्टिफायर को 220 वोल्ट एसी, 50 हर्ट्ज आपूर्ति दी जाती है। इसमें ट्रांसफॉर्मर का टर्न अनुपात 10:1 है एवं फिल्टर कैपेसिटर 470 माइक्रोफैराड है। निम्नलिखित की गणना करें:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>पीक आउटपुट वोल्टेज</li> <li>औसत डीसी आउटपुट वोल्टेज</li> <li>रिप्ल वोल्टेज (लोड = एक किलो ओम)</li> </ul>	4	K3
----	---	---	----

**4. Attempt any one part of the following:****07 x 1 = 07**

Q no.	Question	CO	Level
a.	<p>Discuss the working of JFET and also discuss input and output characteristics of JFET.</p> <p>JFET के कार्य सिद्धांत पर चर्चा कीजिए तथा JFET के इनपुट और आउटपुट विशेषताओं पर भी चर्चा कीजिए।</p>	1,2	K2
b.	<p>Derive the relation between <math>\alpha</math> and <math>\beta</math>. Calculate <math>I_C</math> and <math>I_E</math> for a transistor that has <math>\alpha_{dc} = 0.98</math> and <math>I_C = 100\mu\text{A}</math>. Determine the value of <math>\beta_{dc}</math> for the transistor.</p> <p><math>\alpha</math> और <math>\beta</math> के बीच संबंध स्थापित कीजिए। उस ट्रांजिस्टर के लिए <math>I_C</math> और <math>I_E</math> ज्ञात कीजिए जिसकी <math>\alpha_{dc} = 0.98</math> और <math>I_C = 100\mu\text{A}</math> हो। ट्रांजिस्टर के लिए <math>\beta_{dc}</math> का मान निर्धारित कीजिए।</p>	1	K4

**5. Attempt any one part of the following:****07 x 1 = 07**

Q no.	Question	CO	Level
a.	<p>Explain the working of integrator and differentiator Op-Amp circuits. Include waveform examples and applications.</p> <p>इंटीग्रेटर एवं डिफरेंशिएटर ओप-एम्प परिपथों की कार्यविधि तरंगाकृति उदाहरणों एवं अनुप्रयोगों सहित समझाइए।</p>	1	K2
b.	<p>Design and explain the working of an inverting and non-inverting amplifier. Also derive the gain expressions.</p> <p>इनवर्टिंग तथा नॉन-इनवर्टिंग एम्प्लीफायर की संरचना कीजिए तथा उनके कार्य</p>	3	K3



Paper id: 252360

Printed Page: 4 of 5  
Subject Code: BEC201

Roll No:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**BTECH**  
**(SEM II) THEORY EXAMINATION 2024-25**  
**FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS ENGINEERING**

**TIME: 3 HRS****M.MARKS: 70**

	सिद्धांत को समझाइए। साथ ही, उनके प्रवर्धन (Gain) के समीकरणों की व्युत्पत्ति कीजिए।		
--	--	--	--

**6. Attempt any one part of the following:****07 x 1 = 07**

Q no.	Question	CO	Level
a.	Minimize the four variable logic function using k-map $f(A,B,C,D) = \sum m(0,1,2,3,5,7,8,9,11,14)$ चार चर (variable) वाले लॉजिक फ़ंक्शन को के-मैप की सहायता से सरलतम रूप में व्यक्त करें : $f(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 14)$	4	K2
b.	Prove the following using the Boolean algebraic theorems (i) $A + \bar{A}.B + A\bar{B} = A + B$ (ii) $A.B + \bar{A}.B + \bar{A}. \bar{B} = \bar{A} + B$ (iii) $AB + \bar{A}C + BC = AB + \bar{A}C$ निम्नलिखित को बूलियन बीजगणितीय प्रमेयों (Boolean Theorems) का प्रयोग करके सिद्ध करें : (i) $A + \bar{A}.B + A\bar{B} = A + B$ (ii) $A.B + \bar{A}.B + \bar{A}. \bar{B} = \bar{A} + B$ (iii) $AB + \bar{A}C + BC = AB + \bar{A}C$	2	K4

**7. Attempt any one part of the following:****07 x 1 = 07**

Q no.	Question	CO	Level
a.	What is need of modulation? Define AM (Amplitude modulation) with wave forms and derive expression for modulation index of AM. मॉडुलेशन की आवश्यकता क्या है? तरंग आरेखों सहित AM (एम्प्लीट्यूड मॉडुलेशन) को परिभाषित कीजिए तथा AM के मॉडुलेशन इंडेक्स के लिए समीकरण व्युत्पन्न कीजिए।	3	K2
b.	Explain basic elements of Satellite communication system with help of suitable diagrams.	4	K3



Paper id: 252360

Printed Page: 5 of 5  
Subject Code: BEC201

Roll No:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**BTECH**  
**(SEM II) THEORY EXAMINATION 2024-25**  
**FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS ENGINEERING**

**TIME: 3 HRS**

**M.MARKS: 70**

	एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम के मूल घटकों को उपयुक्त आरेखों (diagrams) की सहायता से समझाइए।		
--	--	--	--

QP25EP1\_292  
/ 11-Jul-2025 9:00:01 AM | 115.240.65.194



PAPER ID-311476

Printed Page: 1 of 3  
Subject Code: KEC101T

Roll No:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**BTECH**  
**(SEM I) THEORY EXAMINATION 2024-25**  
**EMERGING DOMAIN IN ELECTRONICS ENGINEERING**

**TIME: 3 HRS****M.MARKS: 100****Note:** Attempt all Sections. In case of any missing data; choose suitably.**SECTION A****1. Attempt all questions in brief.****2 x 10 = 20**

Q no.	Question	CO	Level
a.	What is the function of a Zener diode in voltage regulation? वोल्टेज विनियमन में जेनर डायोड का क्या कार्य है?	1	K1
b.	What is a varactor diode used for? वैरेक्टर डायोड का उपयोग किस लिए किया जाता है?	1	K2
c.	What are the three configurations of a Bipolar Junction Transistor? द्विध्रुवी जंक्शन ट्रांजिस्टर के तीन विन्यास क्या हैं?	2	K1
d.	How does a MOSFET differ from a JFET? MOSFET, JFET से किस प्रकार भिन्न है?	2	K2
e.	Define differential and common-mode operation in op-amps. ऑप-एम्प में विभेदक और सामान्य-मोड संचालन को परिभाषित करें।	3	K1
f.	What role do microcontrollers play in IoT systems? IoT सिस्टम में माइक्रोकंट्रोलर क्या भूमिका निभाते हैं?	3	K2
g.	What is the difference between SOP (Sum of Products) and POS (Product of Sums) forms in Boolean algebra? बूलियन बीजगणित में SOP (उत्पादों का योग) और POS (योगों का उत्पाद) रूपों के बीच क्या अंतर है?	4	K2
h.	What are SSI, MSI, and LSI in integrated circuits? एकीकृत परिपथों में SSI, MSI और LSI क्या हैं?	4	K2
i.	What are the typical applications of GPRS? GPRS के विशिष्ट अनुप्रयोग क्या हैं?	5	K2
j.	What is the principle of satellite communication? उपग्रह संचार का सिद्धांत क्या है?	5	K2

**SECTION B****2. Attempt any three of the following:****10 x 3 = 30**

Q no.	Question	CO	Level
a.	What is a clipper circuit, and how does it operate? Explain the formation of the depletion layer in a semiconductor diode. क्लिपर सर्किट क्या है और यह कैसे काम करता है? अर्धचालक डायोड में अवक्षय परत के निर्माण की व्याख्या करें।	1	K2
b.	Describe the transfer characteristics of a JFET and derive the relationship between drain current and gate voltage. जेएफईटी की ट्रांसफर विशेषताओं का वर्णन करें और ड्रेन करंट और गेट वोल्टेज के बीच संबंध निकालें।	2	K2
c.	Explain the operation of an inverting amplifier and unit follower using Op-Amps.	3	K2
d.	Describe the working of basic logic gates and universal gates with truth tables. ऑप-एम्प का उपयोग करके इनवर्टिंग एम्पलीफायर और यूनिट फॉलोवर के संचालन की व्याख्या करें।	4	K1
e.	Discuss the need for modulation and describe various modulation techniques. मॉड्यूलेशन की आवश्यकता पर चर्चा करें और विभिन्न मॉड्यूलेशन तकनीकों का वर्णन करें।	5	K2



PAPER ID-311476

Printed Page: 2 of 3  
Subject Code: KEC101T

Roll No:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**BTECH**  
**(SEM I) THEORY EXAMINATION 2024-25**  
**EMERGING DOMAIN IN ELECTRONICS ENGINEERING**

**TIME: 3 HRS****M.MARKS: 100****SECTION C****3. Attempt any one part of the following:****10 x 1 = 10**

Q no.	Question	CO	Level
a.	Discuss the working of a half-wave and full-wave rectifier with circuit diagrams. सर्किट आरेखों के साथ अर्ध-तरंग और पूर्ण-तरंग दिष्टकारी के कार्य पर चर्चा करें।	1	K2
b.	Explain the operation of a tunnel diode with its energy-band diagram and characteristics. टनल डायोड के संचालन को इसके ऊर्जा-बैंड आरेख और विशेषताओं के साथ समझाएँ।	1	K2

**4. Attempt any one part of the following:****10 x 1 = 10**

Q no.	Question	CO	Level
a.	Explain the difference between Depletion-Type and Enhancement-Type MOSFETs with their transfer characteristics. डिप्लेशन-टाइप और एन्हांसमेंट-टाइप MOSFETs के बीच अंतर को उनकी ट्रांसफर विशेषताओं के साथ समझाएँ।	2	K2
b.	Describe the amplification action in a BJT. An npn transistor with $\beta = 97$ is operated in the CB configuration. If the emitter current is 2 mA and reverse saturation current is $12\mu\text{A}$ . What are the base and collector current? BJT में प्रवर्धन क्रिया का वर्णन करें। $\beta = 97$ वाला एक npn ट्रांजिस्टर CB कॉन्फिगरेशन में संचालित होता है। यदि एमिटर करंट 2 mA है और रिवर्स सैचुरेशन करंट $12\mu\text{A}$ है। बेस और कलेक्टर करंट क्या हैं?	2	K3

**5. Attempt any one part of the following:****10 x 1 = 10**

Q no.	Question	CO	Level
a.	Describe the components of an IoT system and their functions. IoT सिस्टम के घटकों और उनके कार्यों का वर्णन करें।	3	K2
b.	How does Bluetooth technology work in IoT applications? Design and draw an inverting amplifier using op-amp with a gain of -10 and $R_i = 20\text{ k}\Omega$ IoT अनुप्रयोगों में ब्लूटूथ तकनीक कैसे काम करती है? -10 के लाभ और $R_i = 20\text{ k}\Omega$ के साथ op-amp का उपयोग करके एक इनवर्टिंग एम्पलीफायर डिज़ाइन करें और बनाएं।	3	K3

**6. Attempt any one part of the following:****10 x 1 = 10**

Q no.	Question	CO	Level
a.	Convert the following numbers as specified: निम्नलिखित संख्याओं को निर्दिष्ट अनुसार परिवर्तित करें:  a) $(101101.101)_2$ to decimal. b) $(745)_8$ to binary. c) $(3F7)_{16}$ to decimal.	4	K3



PAPER ID-311476

Printed Page: 3 of 3  
Subject Code: KEC101T

Roll No:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**BTECH**  
**(SEM I) THEORY EXAMINATION 2024-25**  
**EMERGING DOMAIN IN ELECTRONICS ENGINEERING**

**TIME: 3 HRS****M.MARKS: 100**

	d) $(156)_{10}$ to hexadecimal. e) $(1001101)_2$ to octal.		
b.	Simplify the function $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 5, 6, 7, 13, 14, 15) + d(8, 10)$ using K-map and implement the simplified function using NAND gates only.  K-मैप का उपयोग करके फ़ंक्शन $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 5, 6, 7, 13, 14, 15) + d(8, 10)$ को सरल बनाएँ और केवल NAND गेट का उपयोग करके सरलीकृत फ़ंक्शन को कार्यान्वित करें।	4	K3

**7. Attempt any one part of the following:****10 x 1 = 10**

Q no.	Question	CO	Level
a.	Explain the elements of a communication system with a block diagram. ब्लॉक आरेख के साथ संचार प्रणाली के तत्वों की व्याख्या करें।	5	K2
b.	Explain the general model of wireless communication and its evolution. वायरलेस संचार के सामान्य मॉडल और इसके विकास की व्याख्या करें।	5	K2





PAPER ID-411204

Printed Page: 1 of 3

Subject Code: BEC201

Roll No:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**BTECH**  
**(SEM II) THEORY EXAMINATION 2023-24**  
**FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS ENGINEERING**

**TIME: 3 HRS****M.MARKS: 70**

**Note: 1.** Attempt all Sections. If require any missing data; then choose suitably.

**SECTION A****1. Attempt all questions in brief.****2 x 7 = 14**

Q no.	Question	Marks	CO
a.	What are the functions of clippers and clampers in electronic circuits? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में क्लिपर और क्लैम्पर के क्या कार्य हैं?	2	1
b.	How does a half-wave rectifier differ from a full-wave rectifier? हाफ-वेव रेक्टिफायर फुल-वेव रेक्टिफायर से किस प्रकार भिन्न होता है?	2	1
c.	Explain the operating principle of a BJT. BJT के ऑपरेटिंग सिद्धांत की व्याख्या करें।	2	2
d.	Explain the concept of differential operation in Op-Amps. Op-Amps में डिफरेंशियल ऑपरेशन की अवधारणा की व्याख्या करें।	2	3
e.	What is the significance of universal gates in digital circuits? डिजिटल सर्किट में यूनिवर्सल गेट्स का क्या महत्व है?	2	4
f.	Define the term "combinational logic" in digital electronics. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में "कॉम्बिनेशनल लॉजिक" शब्द को परिभाषित करें।	2	4
g.	Explain the concept of frequency reuse in cellular networks. सेलुलर नेटवर्क में फ्रीक्वेंसी रीयूज की अवधारणा की व्याख्या करें।	2	5

**SECTION B****2. Attempt any three of the following:****7 x 3 = 21**

Q no.	Question	Marks	CO
a.	Draw and explain the V-I characteristics of a semiconductor diode. Explain the functioning of voltage multiplier circuits. अर्धचालक डायोड की V-I विशेषताओं को ड्रा करें और समझाएँ। वोल्टेज गुणक सर्किट की कार्यप्रणाली की व्याख्या करें।	7	1
b.	Discuss the common collector (CC) configurations of a BJT. BJT के कॉमन कलेक्टर (CC) विन्यास पर चर्चा करें।	7	2
c.	Explain the circuit configuration of a summing amplifier using an Op-Amp and derive the voltage gain Op-Amp का उपयोग करके समिंग एम्पलीफायर के सर्किट विन्यास की व्याख्या करें और वोल्टेज गेन निकालें।	7	3
d.	Explain the basic laws and theorems of Boolean algebra बूलियन बीजगणित के मूल नियमों और प्रमेयों की व्याख्या करें।	7	4



PAPER ID-411204

Printed Page: 2 of 3

Subject Code: BEC201

Roll No:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**BTECH**  
**(SEM II) THEORY EXAMINATION 2023-24**  
**FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS ENGINEERING**

**TIME: 3 HRS****M.MARKS: 70**

e.	Explain why modulation is necessary in communication systems. Explain the demodulation techniques used to retrieve the original signal from an AM waveform. संचार प्रणालियों में मॉड्यूलेशन क्यों आवश्यक है, इसकी व्याख्या करें। AM तरंग से मूल सिग्नल को पुनः प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली डिमॉड्यूलेशन तकनीकों की व्याख्या करें।	7	5
----	---	---	---

**SECTION C****3. Attempt any one part of the following:****7 x 1 = 7**

Q no.	Question	Marks	CO
a.	Explain the breakdown mechanisms in Zener diodes जेनर डायोड में ब्रेकडाउन मैकेनिज्म की व्याख्या करें।	7	1
b.	Describe the structure and working principle of Light-Emitting Diodes (LEDs). Discuss their applications in electronics. प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) की संरचना और कार्य सिद्धांत का वर्णन करें। इलेक्ट्रॉनिक्स में उनके अनुप्रयोगों पर चर्चा करें।	7	1

**4. Attempt any one part of the following:****7 x 1 = 7**

Q no.	Question	Marks	CO
a.	Describe the construction of N channel Junction Field Effect Transistors (JFETs). Explain how the gate controls the conductivity of the channel. एन चैनल जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर (JFETs) के निर्माण का वर्णन करें। समझाएँ कि गेट चैनल की चालकता को कैसे नियंत्रित करता है।	7	2
b.	Explain the operation and characteristics of Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistors (MOSFETs). Differentiate between depletion-mode and enhancement-mode MOSFETs. मेटल-ऑक्साइड-सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर (MOSFETs) के संचालन और विशेषताओं की व्याख्या करें। डिप्लेशन-मोड और एन्हांसमेंट-मोड MOSFETs के बीच अंतर करें।	7	2

**5. Attempt any one part of the following:****7 x 1 = 7**

Q no.	Question	Marks	CO
a.	Explain the circuit configuration of an inverting amplifier using an Op-Amp. ऑप-एम्प का उपयोग करके इनवर्टिंग एम्पलीफायर के सर्किट कॉन्फिगरेशन की व्याख्या करें।	7	3
b.	What are Operational Amplifiers (Op-Amps)? Discuss their ideal	7	3



PAPER ID-411204

Printed Page: 3 of 3

Subject Code: BEC201

Roll No:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**BTECH**  
**(SEM II) THEORY EXAMINATION 2023-24**  
**FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS ENGINEERING**

TIME: 3 HRS

M.MARKS: 70

	characteristics and practical limitations. ऑपरेशनल एम्प्लीफायर (ऑप-एम्प) क्या हैं? उनकी ideal विशेषताओं और प्रैक्टिकल सीमाओं पर चर्चा करें।		
--	--	--	--

6. Attempt any *one* part of the following:

7 x 1 = 7

Q no.	Question	Marks	CO
a.	Simplify the following function using K-map $F(A, B, C, D) = \Sigma(1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15)$ . Also implement the simplified function using basic gates only. K-मैप का उपयोग करके निम्नलिखित फंक्शन को सरल बनाएँ। $F(A, B, C, D) = \Sigma(1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15)$ । केवल बेसिक गेट का उपयोग करके सरलीकृत फंक्शन को भी लागू करें।	7	4
b.	Realize NOT, AND, OR and XOR gates using NAND gate. NAND गेट का उपयोग करके NOT, AND, OR और XOR गेट को इम्प्लेमेंट करें।	7	4

7. Attempt any *one* part of the following:

7 x 1 = 7

Q no.	Question	Marks	CO
a.	Define wireless communication and its significance in modern telecommunications. Explain the basic principles of radar operation वायरलेस संचार को परिभाषित करें और आधुनिक दूरसंचार में इसका महत्व बताएं। रडार संचालन के मूल सिद्धांतों की व्याख्या करें।	7	5
b.	Explain the basics of satellite communication systems. Describe the evolution from 1G to 5G cellular networks. उपग्रह संचार प्रणालियों की मूल बातें समझाएं। 1G से 5G सेलुलर नेटवर्क तक के विकास का वर्णन करें।	7	5



PAPER ID-311338

Printed Page: 1 of 2

Subject Code: BEC101

Roll No:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**BTECH**  
**(SEM I) THEORY EXAMINATION 2023-24**  
**FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS ENGINEERING**

**TIME: 3HRS****M.MARKS: 70**

**Note: 1.** Attempt all Sections. If require any missing data; then choose suitably.

**SECTION A****1. Attempt all questions in brief.****2 x 7 = 14**

Q no.	Question	Marks	CO
a.	Explain the difference between the P-N junction diode and Light-Emitting diode.	2	1
b.	Why BJT is called a current controlled device?	2	2
c.	What is the basic difference between JFET and MOSFET?	2	2
d.	Add binary numbers $(1110.10 + 1011.11)_2$ .	2	4
e.	Simplify the Boolean function $F = XY + XY'Z + YZ'$ using Boolean algebra.	2	4
f.	Explain the concept of virtual ground in OP-Amp.	2	3
g.	Write the two applications of Satellite communication.	2	5

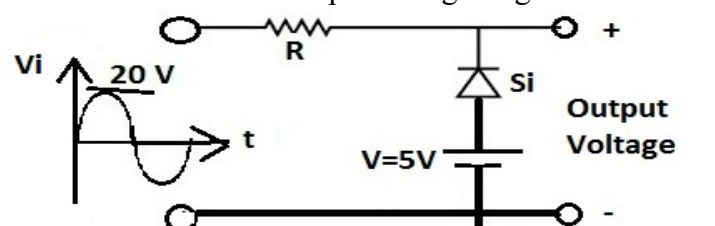
**SECTION B****2. Attempt any three of the following:****7 x 3 = 21**

a.	Define the static and dynamic resistance of the Diode. Also differentiate between Transition and Diffusion capacitance.	7	1
b.	Draw and explain the working of the P-N-P Transistor in common-base (CB) configuration with its characteristic graphs.	7	2
c.	Define the common mode rejection ratio. Determine the output voltage of a differential amplifier for the input voltages of $300\mu\text{V}$ and $240\mu\text{V}$ . The differential gain is 5000 and the value of CMRR is 100.	7	3
d.	Perform the following as mentioned: (i) Convert $(63.250)_{10}$ to binary number. (ii) Convert $(10010.101)_2$ to decimal number. (iii) Convert $(A6B.0F)_{16}$ to octal number. (iv) Perform subtraction using 2's complement $(111-1010)_2$ . (v) Design AND, OR, and NOT gates using only NOR gates.	7	4
e.	Explain the need of modulation in the communication system.	7	5

**SECTION C****3. Attempt any one part of the following:****7 x 1 = 7**

a.	Draw and explain the construction and working of N-channel JFET with characteristic graphs.	7	2
b.	Draw and explain the construction and working of P-channel Depletion MOSFET with characteristic graphs.	7	2

**4. Attempt any one part of the following:****7 x 1 = 7**

a.	Determine and draw the output voltage of given network. 	7	1
----	---	---	---



PAPER ID-311338

Printed Page: 2 of 2

Subject Code: BEC101

Roll No:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**BTECH**  
**(SEM I) THEORY EXAMINATION 2023-24**  
**FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS ENGINEERING**

TIME: 3HRS

M.MARKS: 70

b.	Determine and draw the output voltage of given network.	7	1

5. Attempt any one part of the following:

7 x 1 = 7

Q no.	Question	Marks	CO
a.	Draw the circuit diagram and explain the working of the Subtractor using OP-Amp. Also, derive the expression for the output voltage.	7	3
b.	Determine the output voltage of the given network.	7	3

6. Attempt any one part of the following:

7 x 1 = 7

Q no.	Question	Marks	CO
a.	Simplify the function $F = \sum m(0,3,5,7,8,9,10,12,13) + \sum d(1,6,11,14)$ using K-map and implement the simplified expression using NAND gates only.	7	4
b.	Simplify the function $F = \prod M(0, 2, 10, 11, 12, 14, 15) \cdot \prod d(5,13)$ using K-map and implement the simplified expression using NOR gates only.	7	4

7. Attempt any one part of the following:

7 x 1 = 7

Q no.	Question	Marks	CO
a.	In an amplitude-modulated wave, derive the expression for (i) Amplitude of sidebands (ii) Sideband frequencies (iii) Modulation Index (iv) Modulation Efficiency	7	5
b.	Write short notes on (i) Amplitude Modulation technique (ii) Radar Communication	7	5

## B. TECH.

(SEM II) THEORY EXAMINATION 2022-23  
FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS ENGINEERING

Time: 3 Hours

Total Marks: 70

समय: 03 घण्टे

पूर्णांक: 70

## Note:

1. Attempt all Sections. If require any missing data; then choose suitably.
2. The question paper may be answered in Hindi Language, English Language or in the mixed language of Hindi and English, as per convenience.

नोट: 1. सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किसी प्रश्न में, आवश्यक डेटा का उल्लेख न होने की स्थिति में उपयुक्त डेटा स्वतः मानकर प्रश्न को हल करें।  
2. प्रश्नों का उत्तर देने हेतु सुविधानुसार हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा अथवा हिंदी एवं अंग्रेजी की मिश्रित भाषा का प्रयोग किया जा सकता है।

## SECTION A

## 1. Attempt all questions in brief.

2 x 7 = 14

निम्न सभी प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दीजिए।

- (a) What do you mean by Varactor diode? Write its one application.  
वैरेक्टर डायोड से आप क्या समझते हैं? इसका एक अनुप्रयोग लिखिए।
- (b) Why FET is a voltage-controlled device?  
स्पष्ट करें कि क्यों FET एक वोल्टेज-नियंत्रित उपकरण है?
- (c) Write down the characteristics of Ideal OP-AMP.  
आदर्श OP-AMP की विशेषताएँ लिखिए।
- (d) The output of particular OP-AMP increases 8V in 12 $\mu$ s. What is the slew rate?  
एक विशेष OP-AMP का आउटपुट 12 $\mu$ s में 8V बढ़ जाता है। slew rate क्या है?
- (e) Derive relation between current gain in CB and CE configuration of Transistor.  
ट्रांजिस्टर के CB और CE कॉन्फिगरेशन में current gain के बीच संबंध व्युत्पन्न करें।
- (f) Calculate the 1's and 2's complement of binary number 1010101.  
बाइनरी संख्या 1010101 के 1's और 2's complement की गणना करें।
- (g) Define modulation index for AM wave.  
AM तरंग के लिए मोड्यूलेशन इंडेक्स को परिभाषित करें।

## SECTION B

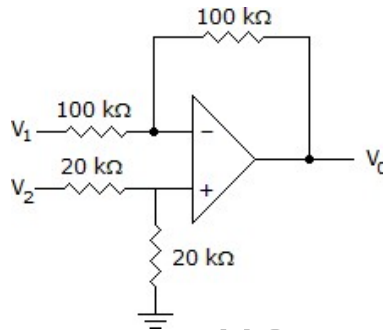
## 2. Attempt any three of the following:

7 x 3 = 21

निम्न में से किसी तीन प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

- (a) Define the various elements of communication system and also draw its functional block diagram.  
संचार प्रणाली के विभिन्न तत्वों को परिभाषित करें और इसका फंक्शनल ब्लॉक आरेख बनायें।
- (b) Draw and explain the working of N-P-N transistor in common Emitter configuration with its suitable characteristic graph.  
सामान्य एमिटर कॉन्फिगरेशन में एन-पी-एन ट्रांजिस्टर की कार्यप्रणाली को उसके उपयुक्त विशेषता (characteristic) ग्राफ के साथ बनाएं और समझाएं।

- (c) Simplify the Boolean function  $F = \sum m (0,1,2,5,7,8,9,10,13,15) + d (12,14)$  using K-map and implement the simplified expression using NAND gates only. K-मैप का उपयोग करके बूलियन फंक्शन  $F = \sum m (0,1,2,5,7,8,9,10,13,15) + d (12,14)$  को सरल बनाएं और केवल NAND गेट्स का उपयोग करके सरलीकृत अभिव्यक्ति को लागू करें।
- (d) Draw and explain the working of Centre-Taped full wave rectifier. Also calculate its efficiency and ripple factor. सेंटर-टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर की कार्यप्रणाली का चित्र बनाएं और समझाएं। इसकी दक्षता और ripple factor की भी गणना करें।
- (e) Explain unity gain amplifier. Determine the output voltage of the following network. यूनिटी गेन एम्प्लीफायर को समझाइये। निम्नलिखित नेटवर्क का आउटपुट वोल्टेज निर्धारित करें।



### SECTION C

3. Attempt any *one* part of the following:

7 x 1 = 7

निम्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए।

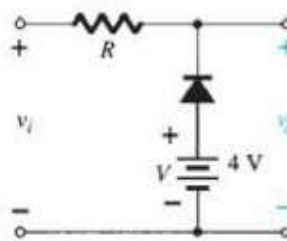
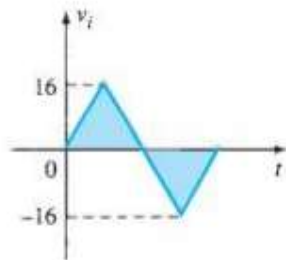
- (a) Explain the construction, working and characteristics of n-channel Depletion MOSFET.  
n-channel Depletion MOSFET के निर्माण, कार्यप्रणाली और विशेषताओं को समझाएं।
- (b) Explain the construction, working and characteristics of n-channel Enhancement MOSFET.  
n-channel Enhancement MOSFET के निर्माण, कार्यप्रणाली और विशेषताओं को समझाएं।

4. Attempt any *one* part of the following:

7 x 1 = 7

निम्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए।

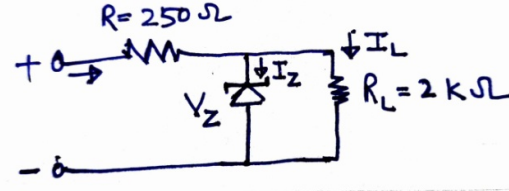
- (a) Determine and draw the output voltage of given network.  
दिए गए नेटवर्क का आउटपुट वोल्टेज निर्धारित करें और उसका आरेख बनाएं।



- (b) Determine the range of input voltage ( $V_s$ ) for the Zener diode to remain in ON state shown in following figure. Given that  $V_Z = 20V$ ,  $I_{Zmax} = 50mA$ ,  $R_Z = 0\Omega$ .



निम्नलिखित चित्र में दिखाए गए जेनर डायोड को ON स्थिति में रहने के लिए इनपुट वोल्टेज ( $V_s$ ) की रेंज निर्धारित करें। दिया गया है कि  $V_Z=20V$ ,  $I_{Zmax}=50mA$ ,  $R_Z=0\Omega$ ।



5. Attempt any *one* part of the following:

7 x 1 = 7

निम्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए।

- With the help of the circuit diagram, explain the working of OP-AMP as a non-Inverting summer.  
सर्किट आरेख की सहायता से OP-AMP को non-Inverting summer के रूप में कार्यप्रणाली को समझाइए।
- With the help of the circuit diagram, explain the working of OP-AMP as an Integrator.  
सर्किट आरेख की सहायता से एक Integrator के रूप में OP-AMP की कार्यप्रणाली को समझाइए।

6. Attempt any *one* part of the following:

7 x 1 = 7

निम्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए।

- Simplify the following Boolean expression using K-map.  
K-मैप का उपयोग करके निम्न बूलियन अभिव्यक्ति को सरलतम बनाएं।  
 $f(V, W, X, Y, Z) = \sum m(0, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 22, 23, 30, 31)$
- Simplify the Boolean expression using K-map and implement the simplified expression using NOR GATES only.  
K-मैप का उपयोग करके बूलियन अभिव्यक्ति को सरलतम बनाएं और केवल NOR GATES का उपयोग करके सरलीकृत अभिव्यक्ति को लागू करें।  
 $F(A, B, C, D) = \prod M(1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15)$

7. Attempt any *one* part of the following:

7 x 1 = 7

निम्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए।

- An audio frequency signal  $10\sin 2\pi \times 500t$  is used to amplitude modulate a carrier of  $50\sin 2\pi \times 10^5t$ . Calculate:
  - Modulation index
  - Amplitude of Each side band
  - Total power delivered to the load of  $2 K\Omega$ .
  - Bandwidth
 एक ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल  $10\sin 2\pi \times 500t$  का उपयोग  $50\sin 2\pi \times 10^5t$  के कैरियर को आयाम मॉड्यूलेट करने के लिए किया जाता है। गणना करें:
  - मॉड्यूलेशन इंडेक्स
  - प्रत्येक साइड बैंड का आयाम
  - $2 K\Omega$  के लोड तक पहुंचाई गई कुल पॉवर।
  - बैंडविड्थ
- Derive the transmission efficiency and total power of amplitude modulated wave assuming message and carrier wave as sinusoidal wave.  
संदेश और वाहक तरंग को साइनसाइडल तरंग मानकर आयाम संग्राहक तरंग की संचरण दक्षता और कुल शक्ति का व्यंजक प्राप्त करें।



**B TECH**  
**(SEM I) THEORY EXAMINATION 2022-23**  
**FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS ENGINEERING**

Time: 3 Hours

Total Marks: 70

समय: 03 घण्टे

पूर्णांक: 70

**Note:**

1. Attempt all Sections. If require any missing data; then choose suitably.
2. The question paper may be answered in Hindi Language, English Language or in the mixed language of Hindi and English, as per convenience.

**नोट:** 1. सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किसी प्रश्न में, आवश्यक डेटा का उल्लेख न होने की स्थिति में उपयुक्त डेटा स्वतः मानकर प्रश्न को हल करें।  
2. प्रश्नों का उत्तर देने हेतु सुविधानुसार हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा अथवा हिंदी एवं अंग्रेजी की मिश्रित भाषा का प्रयोग किया जा सकता है।

**SECTION A****1. Attempt all questions in brief.****2 x 7 = 14**

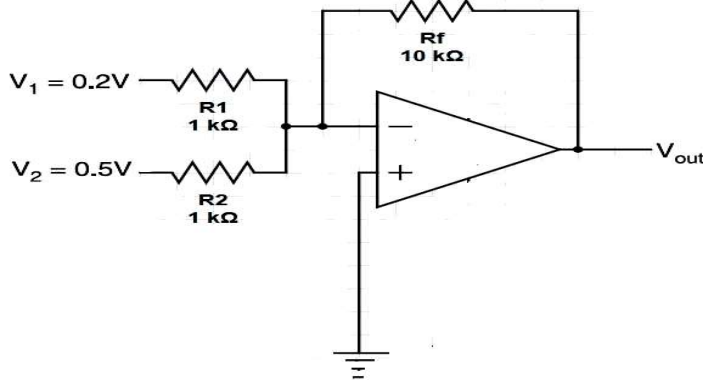
निम्न सभी प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दीजिए।

a.	Compare between Avalanche breakdown and Zener breakdown अवलांची (Avalanche) ब्रेकडाउन और जेनर (Zener) ब्रेकडाउन के बीच तुलना करें
b.	Why Varactor diode is also called Varicap? Explain. Varactor डायोड को Varicap भी क्यों कहते हैं? व्याख्या कीजिए।
c.	Define Pinch-off voltage for JFET. JFET के लिए पिच-ऑफ (Pinch-off) वोल्टेज को परिभाषित करें।
d.	For a transistor $I_E = 10 \text{ mA}$ and $\alpha = 0.987$ . Find $I_C$ and $I_B$ एक ट्रांजिस्टर के लिए $I_E = 10 \text{ mA}$ और $\alpha = 0.987$ है। $I_C$ और $I_B$ का मान ज्ञात कीजिए।
e.	Define CMRR and Slew rate of Op-Amp Op-Amp के CMRR और Slew rate को परिभाषित करें
f.	Explain Voltage Follower circuit using Op-Amp. Op-Amp का प्रयोग करते हुए वोल्टेज फॉलोअर सर्किट को समझाइए।
g.	500 watt carrier power is modulated to depth of 90%, calculate the total power in the modulated wave. 500 वाट वाहक शक्ति को 90% की गहराई तक संशोधित किया जाता है। संग्राहक तरंग में कुल शक्ति की गणना करें।

**SECTION B****2. Attempt any three of the following:****7 x 3 = 21**

निम्न में से किसी तीन प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

a.	Explain the working of p-n junction diode and draw its V-I Characteristics. p-n संधि डायोड की कार्यप्रणाली समझाइए तथा इसके V-I अभिलक्षण को रेखाचित्र से प्रदर्शित कीजिए।
b.	Draw a neat circuit diagram of bridge rectifier and explain its operation with output waveforms. Drive the average value of current and voltage.

	ब्रिज रेक्टिफायर का स्वच्छ परिपथ आरेख बनाइए तथा आउटपुट वेवफॉर्म के साथ इसकी कार्यप्रणाली समझाइए। करेन्ट और वोल्टेज के औसत मान को व्युत्पन्न कीजिए।
c.	<p>Calculate the output voltage <math>V_o</math> of the circuit shown in fig 1. चित्र 1 में दिखाए गए सर्किट के आउटपुट वोल्टेज <math>V_o</math> की गणना करें।</p>  <p style="text-align: center;">Fig No 1</p>
d.	Define Universal Gates. Implement AND, OR, NOR by using NAND gates only.
	यूनिवर्सल गेट को परिभाषित कीजिए। केवल NAND गेट का उपयोग करके AND, OR और NOR गेट लागू करें।
e.	<p>An audio frequency signal <math>20 \sin 2\pi \times 500 t</math> is used to amplitude modulated a carrier of <math>40 \sin 2\pi \times 10^5 t</math>. Calculate :</p> <p>(i) Modulation Index      (ii) Sideband Frequency      (iii) Amplitude of each sideband (iv) Bandwidth required      (v) Total power delivered to the load of <math>2 K\Omega</math></p> <p>एक ऑडियो आवृत्ति सिग्नल <math>20 \sin 2\pi \times 500 t</math> का उपयोग एक वाहक <math>40 \sin 2\pi \times 10^5 t</math> के को आयाम माड्यूलेशन करने के लिए किया जाता है। गणना करें:</p> <p>(i) मॉड्यूलेशन इंडेक्स (ii) साइडबैंड फ्रीक्वेंसी (iii) प्रत्येक साइडबैंड का आयाम (iv) आवश्यक बैंडविड्थ (v) <math>2 K\Omega</math> के भार पर खर्च होने वाली कुल शक्ति (Total power)</p>

### SECTION C

**3. Attempt any one part of the following:**

**7 x 1 = 7**

निम्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए।

(a)	<p>(i) Draw the circuit diagram of voltage tripler circuit? (ii) Explain Zener diode as a voltage regulator.</p>
	<p>(i) वोल्टेज ट्रिपलर सर्किट का सर्किट आरेख बनाएं? (ii) वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में जेनर डायोड का उपयोग समझाइए।</p>
(b)	<p>Explain the working of following with the help of suitable diagram. (i) LED (ii) Photodiodes.</p>
	<p>उपयुक्त आरेख की सहायता से निम्नलिखित की कार्यप्रणाली समझाइए। (i) एलईडी (LED) (ii) फोटोडायोड्स (Photodiodes)</p>

**4. Attempt any one part of the following:**

**7 x 1 = 7**

निम्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए।

(a)	Draw the circuit of NPN transistor in common base configuration and discuss its working. Draw input-output characteristic.
-----	--

	उभयनिष्ठ आधार (common base) विन्यास में NPN ट्रांजिस्टर का परिपथ बनाइए तथा इसकी कार्यप्रणाली की विवेचना कीजिए। इसकी इनपुट-आउटपुट विशेषता को रेखाचित्र से प्रदर्शित करें।
(b)	Explain working principle of Depletion type MOSFET (n-channel). Draw & Explain its characteristics.
	डिप्लेशन टाइप MOSFET (n-channel) के कार्य सिद्धांत की व्याख्या करें। चित्र बनाइए और इसकी विशेषताओं को समझाइए।

5. Attempt any **one** part of the following:

7 x 1 = 7

निम्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए।

(a)	Draw the block diagram of Op-Amp and list all the ideal characteristics of op-amp.
	Op-Amp का ब्लॉक आरेख बनाएं और op-amp की सभी आदर्श विशेषताओं को सूचीबद्ध करें।
(b)	Explain the working of op-amp as a Integrator and drive its output equation.
	इंटीग्रेटर के रूप में Op-Amp की कार्यप्रणाली समझाइए और इसके आउटपुट समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए।

6. Attempt any **one** part of the following:

7 x 1 = 7

निम्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए।

(a)	Minimize using K-map and realize output using gates. $F(A, B, C, D) = \sum m(1, 4, 8, 12, 13, 15) + d(3, 14)$
	के-मैप (K-map) का उपयोग हुए निम्न फंक्शन का सरलतम रूप ज्ञात करें और गेट्स का उपयोग करके आउटपुट प्राप्त करें। $F(A, B, C, D) = \sum m(1, 4, 8, 12, 13, 15) + d(3, 14)$
(b)	Convert the following: i) $(53.625)_{10}$ to $(?)_2$ ii) Find the base x if $(211)_x = (152)_8$ iii) Subtract using 1's complement: $(10111)_2 - (110011)_2$ iv) find the 1's and 2's compliment of $(010100)_2$
	निम्नलिखित को रूपांतरित करें: i) $(53.625)_{10}$ से $(?)_2$ ii) यदि $(211)_x = (152)_8$ है तो आधार x ज्ञात कीजिए iii) 1's complement का उपयोग करके घटाएं: $(10111)_2 - (110011)_2$ iv) $(010100)_2$ के लिए 1's and 2's compliment लिखें।

7. Attempt any **one** part of the following:

7 x 1 = 7

निम्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए।

(a)	(i) Describe AM modulator with adequate diagram. (ii) Explain the elements of communication system with the help of block diagram.
	(i) AM मॉड्यूलैटर को उचित आरेख के साथ वर्णन कीजिए। (ii) आरेख की सहायता से संचार तंत्र के तत्वों की व्याख्या कीजिए।
(b)	Explain the satellite and radar system using proper block diagram.
	समुचित रेखाचित्र की सहायता से उपग्रह और रडार सिस्टम की व्याख्या करें।